

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 19 年 7 月 19 日 (2007.7.19)

【公開番号】特開 2006-3099 (P2006-3099A)  
 【公開日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)  
 【年通号数】公開・登録公報 2006-001  
 【出願番号】特願 2004-176853 (P2004-176853)  
 【国際特許分類】

**G 0 1 L 9/00 (2006.01)**

**H 0 1 L 29/84 (2006.01)**

【F I】

G 0 1 L 9/00 3 0 3 E

G 0 1 L 9/00 3 0 3 F

H 0 1 L 29/84 B

【手続補正書】  
 【提出日】平成 19 年 6 月 5 日 (2007.6.5)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】請求項 1 1  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【請求項 1 1】

ダイヤフラム部を有する半導体基板に 1 つ以上の歪み検出素子が設けられた半導体圧力センサの製造方法において、

前記半導体基板に前記歪み検出素子を形成する工程と、

前記半導体基板に前記ダイヤフラム部を形成する工程とを有し、

前記歪み検出素子の少なくとも 1 つを、前記ダイヤフラム部に第 1 の端部を有し、該第 1 の端部と前記ダイヤフラム部のエッジ間の距離を  $LX$  としたとき、 $LX \geq 20 \mu m$  となるように、前記ダイヤフラム部の内側と外側とに跨って配置することを特徴とする半導体圧力センサの製造方法。

【手続補正 2】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 1 6  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【0 0 1 6】

S O I 基板 2 は、半導体材料としてのシリコンからなる支持層 2 a と表面層 2 c との間に埋め込み酸化膜 (絶縁層) 2 b が介在した 3 層構造の基板である。この S O I 基板 2 の一部の領域において、支持層 2 a が除去されることで、残りの埋め込み酸化膜 2 b および表面層 2 c の部分でダイヤフラム 3 が構成される。